



ES2A – ES2J

**2 амперный
супербыстродействующий диод**

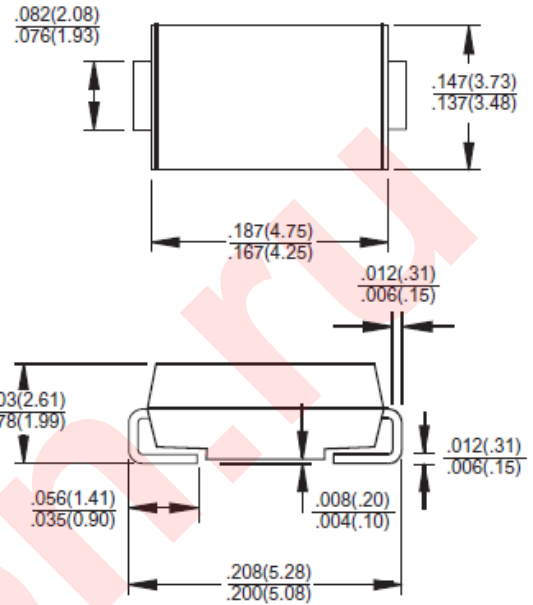
**диапазон напряжения
от 50 до 600 вольт
ток 2 ампера
SMB/DO-214AA**

ОСОБЕННОСТИ:

- Пассивированный стеклом чип, SMD
- Низкопрофильный
- Идеально подходит для автоматизированного размещения на печатной плате
- Супер быстрое время восстановления
- Номинальное напряжение до 600В
- Высокая температура пайки: 260°C в течении 10сек.
- Пластиковые материалы UL классификация воспламеняемости 94 V-0

Механические данные

- Корпус: литой пластиковый корпус DO-214AA
- Вывода: покрытые припоем
- Полярность: маркируется катод
- Упаковка: 12 мм лента STD RS-481
- Вес: 0,093 грамма



Размеры в дюймах и (мм)

МАКСИМАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значения параметров при 25°C температуре окружающей среды, если не указано иное.

Однофазный, напряжение (В) половина волны, частота – 60 Гц, для резистивных и индуктивных нагрузок.

Для емкостной нагрузки уменьшайте ток на 20%

ТИП		ES2A	ES2B	ES2C	ES2D	ES2F	ES2G	ES2H	ES2J	Единица измерения
Максимальное пиковое импульсное обратное напряжение	V _{RRM}	50	100	150	200	300	400	500	600	В
Максимальное среднеквадратическое значение напряжения	V _{RMS}	35	70	105	140	210	280	350	420	В
Максимальное постоянное запирающее напряжение	V _{DC}	50	100	150	200	300	400	500	600	В
Максимальный средний прямой выпрямленный ток T = 55°C	I _{F(AV)}	2.0								А
Максимальный прямой ток импульса в течении 8.3 мсек. (JEDEC метод)	I _{FSM}	50								А
Максимальное падение напряжения на открытом диоде при прямом токе 1А	V _F	0.95			1.3			1.7		В
Максимальный постоянный обратный ток при номинальном постоянном обратном напряжении T _J = 25°C T _J = 100°C	I _R	10				350				мкА
Типичное время обратного восстановления (Примечание 2)	T _{RR}	35								нсек.
Типичная емкость перехода, на выводах (Примечание 1)	C _J	10				8				пФ
Типичное тепловое сопротивление	R _{θJA} R _{θJL}	75				20				°C/Вт
Диапазон рабочих температур	T _J	-55 до +150								°C
Диапазон температур хранения	T _{STG}	-55 до +150								°C

Примечание: 1. Измеряется на частоте 1.0 МГц и обратном постоянном напряжении 4,0 В.

2. Обратное восстановление, условия тестирования: I_F = 0.5А, I_R = 1,0А, I_{RR} = 0.25А.

ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИК ES2A – ES2J



FIG.1- MAXIMUM FORWARD CURRENT DERATING CURVE

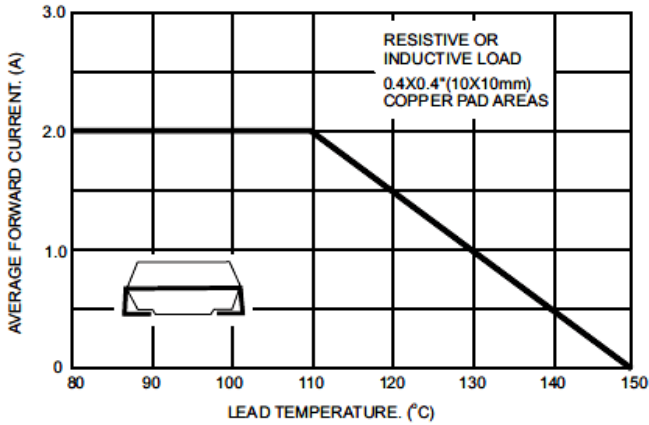


FIG.2- MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT

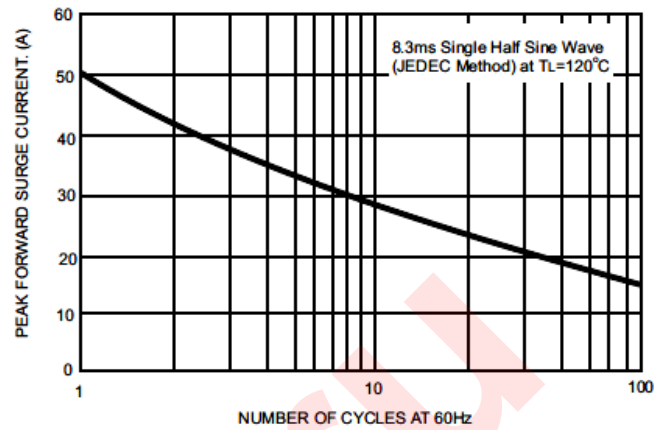


FIG.3- TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

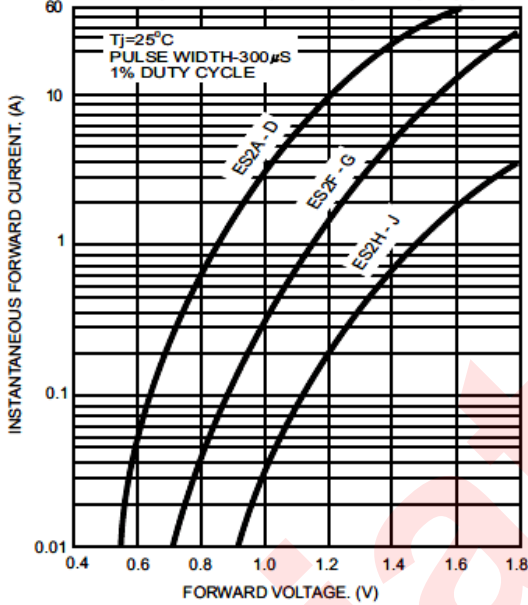


FIG.4- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

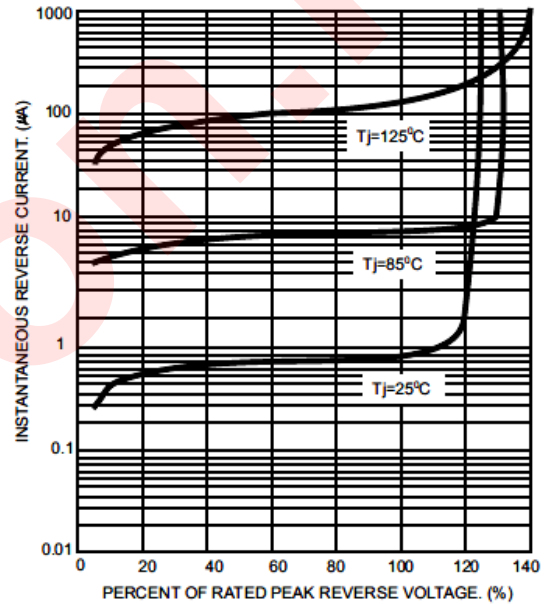


FIG.5- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE

